

(19) (KR)
(12) (B1)

(21)	10-1997-0001443	(65)	10-1997-0060400
(22)	1997 01 20	(43)	1997 08 12

(30) 96-011481 1996 01 26 (JP)

(72) 가 1126-1-3

1903-75-405

4-62-1505

가 2 1 11-203

(74)

2

(54)

1 (a) (e)

2

가

,

가

가

3 (a) (d)

4 3

가

,

5 (a) (d)

<

>

1, 11, 21 :

2, 12, 22 :

3, 13, 23 :

4, 14, 24 :

5, 15, 25 :

6, 17 :

7 :

16, 26 :

가

(spontaneous polarization)

DRAM(

RAM)

(Pt)

가

(Cl₂) 가

(boiling point)

(melting point)

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

3

가

1 (a) (e) (Si) (Pt), 4 SBT, SrBi₂Ta₃O₉, 2 (SiO₂) (Pt), 6 (Ti), 7
 (5) (6) (1) (2) (3), (4), (5) (6) (7) (1) (a)). (2) CVD (sol-gel process), (3), (4),
 (6) (4) 200 nm, (5) 200 nm, (6) 200 nm, (7) 300 nm, (3) 300 nm,
 1/10 (7) 200 nm, (5), (4) 200 nm, (6) 200 nm, (7) 1200 nm
 (Cl₂) 가 (O₂) (ashing) (Cl₂) (O₂) (1) (b)), (6) (5), (4) (3) (1) (c)).
). 8 cc(cc/cm²) 가 2 Pa 12 cc(cc/13.56 MHz), 1 (d)
 /cm² 가 40 % 가 5 W
 6 MHz 0.7 W/cm² 30 cc(cc/2 Pa), 20 Pa 13.5 (1) (e)
 2 가 2 (1) (2) 1/10
 가 27 % 2 Pa 100 % 13.56 MHz 5 W/cm²
 1 (5), (4) (3) (6) 1/10 (3, 4, 5) 1/10 (3, 4, 5) 30 % (6)
 (3, 4, 5) (7) (3, 4, 5) (6) (3, 4, 5) (7) (3, 4, 5) 1 (d)
 2 (7) (6) (2) (3) (5) (6) (2) (3) (5) (6) (1) (e)
 bZrO₃ Pt SBT Pt SBT, BaTiO₃ - SrTiO₃, PZT, PbTiO₃ - Pt
 (Cr), (Ta), (Al) HBr, SF₆, HC1 Pt O₂
 가 Cl₂ O₂ (Pt) 가 (Al) HBr, SF₆, HC1 Pt O₂

(57)

1

가

2

1

1

30 %

Pt

가

6.

5

7.

5

8.

7

가

가

9.

8

3

가

10.

가

11.

10

12.

10

가









